

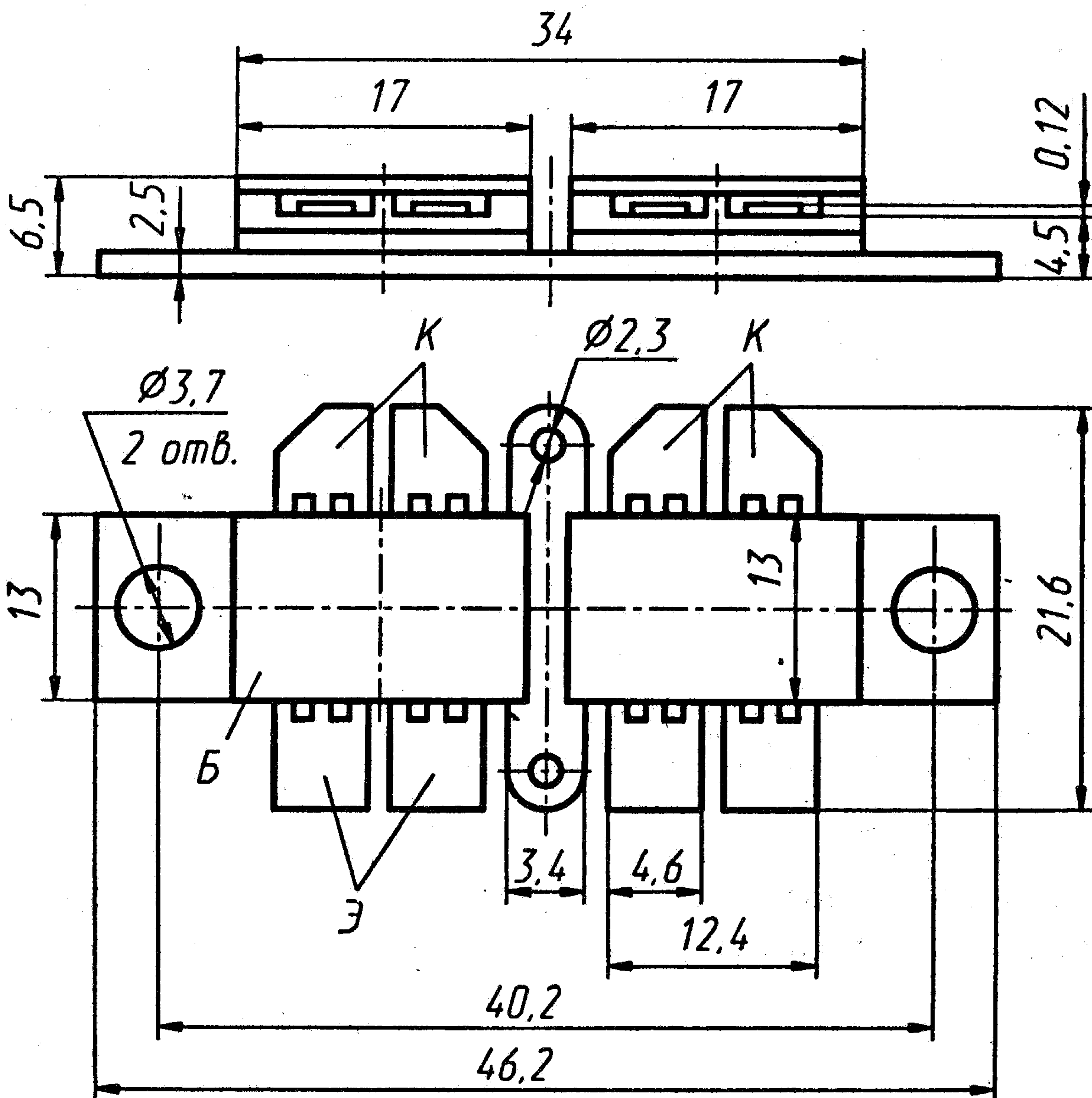
## **A739A-2, A739B-2**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности и генераторах в схеме ОБ при напряжении питания 45 В в составе гибридных интегральных микросхем. Бескорпусные на керамическом кристаллодержателе гибкими выводами. Транзистор содержит внутренние согласующие. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

# A739(A-2, Б-2)



## Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на  $f = 1,5$  ГГц при  $U_{\Pi} = 45$  В,  $t_{\Pi} = 10$  мкс,  $Q = 100$ , не менее:

A739A-2 при $P_{\text{вх}} = 125$ Вт .....	550 Вт
A739Б-2 при $P_{\text{вх}} = 100$ Вт .....	440 Вт

Коэффициент усиления по мощности на  $f = 1,5$  ГГц при  $U_{\Pi} = 45$  В,  $t_{\Pi} = 10$  мкс,  $Q = 100$ ,  $P_{\text{вх}} = 125$  Вт для A739A-2,  $P_{\text{вх}} = 100$  Вт для A739Б-2, не менее .....

6,4 дБ

Коэффициент полезного действия коллектора на  $f = 1,5$  ГГц при  $U_{\Pi} = 45$  В,  $t_{\Pi} = 10$  мкс,  $Q = 100$ ,  $P_{\text{вх}} = 125$  Вт для A739A-2,  $P_{\text{вх}} = 100$  Вт для A739Б-2, не менее .....

30%

Обратный ток коллектора при  $U_{\text{кб}} = 50$  В, не более .....

60 мА

Обратный ток коллектор—эмиттер при  $U_{\text{кэ}} = 45$  В, не более .....

60 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{\text{эб}} = 3$  В, не более .....

80 мА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база.....	50 В
Постоянное напряжение эмиттер—база.....	3 В
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10$ мкс, $Q = 100$ :	
A739A-2.....	78 А
A739B-2.....	63 А
Импульсная рассеиваемая мощность коллек- тора при $t_{и} = 10$ мкс, $Q = 100$ , $T_{к} = +85$ °С:	
A739A-2.....	1300 Вт
A739B-2.....	1000 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода.....	+190 °С
Температура окружающей среды.....	-60... $T_{к} =$ = +125 °С